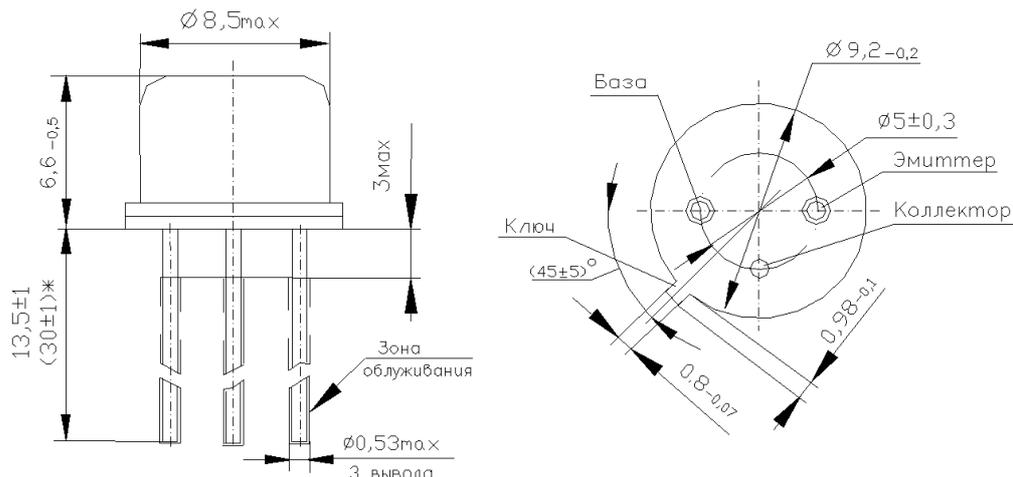


Транзисторы 2Т608А/ИУ

Кремниевые эпитаксиально-планарные n-p-n высокочастотные транзисторы 2Т608А/ИУ в металлостеклянном корпусе КТ-2, предназначены для работы в схемах аппаратуры специального назначения.

Транзисторы соответствуют техническим условиям АЕЯР.432140.402 ТУ.



Масса транзистора не более 1,75 г

Т а б л и ц а 1 - Электрические параметры транзисторов при приемке и поставке ($T=25^{\circ}\text{C}$)

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма	
		не менее	не более
Обратный ток коллектора, ($U_{\text{КБ}}=60\text{В}$), мкА	$I_{\text{КБ0}}$	-	10
Обратный ток эмиттера ($U_{\text{ЭБ}}=4\text{В}$), мкА	$I_{\text{ЭБ0}}$	-	10
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте, ($U_{\text{КЭ}}=10\text{В}$, $I_{\text{К}}=30\text{мА}$, $f=100\text{МГц}$)	$ h_{21Э} $	2	-
Емкость коллекторного перехода ($U_{\text{КБ}}=10\text{В}$, $f=5\text{МГц}$), пФ	$C_{\text{К}}$	-	15
Емкость эмиттерного перехода ($U_{\text{ЭБ}}=0\text{В}$, $f=5\text{МГц}$), пФ	$C_{\text{Э}}$	-	50
Статический коэффициент передачи тока, ($U_{\text{КБ}}=5\text{В}$, $I_{\text{Э}}=200\text{мА}$, $f=50\text{Гц}$)	$h_{21Э}$	25	80
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($I_{\text{К}}=400\text{А}$, $I_{\text{Б}}=80\text{мА}$), В	$U_{\text{КЭнас}}$	-	1,0
Напряжение насыщения база-эмиттер ($I_{\text{К}}=400\text{А}$, $I_{\text{Б}}=80\text{мА}$), В	$U_{\text{БЭнас}}$	-	2,0
Время рассасывания ($I_{\text{К}}=150\text{мА}$, $I_{\text{Б1}}=-I_{\text{Б2}}=15\text{мА}$, $t_{\text{и}}\leq 30\text{мкс}$, $Q\geq 50$), нс	$t_{\text{рас}}$	-	100

Т а б л и ц а 2 - Предельно допустимые значения параметров электрических режимов эксплуатации

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В	$U_{\text{КБ макс}}$	60
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер, В	$U_{\text{КЭ макс}}$	60
Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер (при $R_{\text{с}}\leq 1\text{кОм}$, $\tau_{\text{и}}\leq 10\text{мкс}$, $Q\geq 2$), В	$U_{\text{КЭ и макс}}$	75
Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, В	$U_{\text{ЭБ макс}}$	4
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, мА	$I_{\text{К макс}}$	400
Максимально допустимый импульсный ток коллектора ($\tau_{\text{и}}\leq 10\text{мкс}$, $Q\geq 2$), мА	$I_{\text{К и макс}}$	800
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт	$P_{\text{к макс}}$	0,5
Максимально допустимая температура перехода, $^{\circ}\text{C}$	$T_{\text{пер. макс}}$	150
Тепловое сопротивление, $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$	$R_{\text{тп-окр. ср.}}$	200
Температура окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	$T_{\text{окр. ср}}$	От минус 60 до 125